

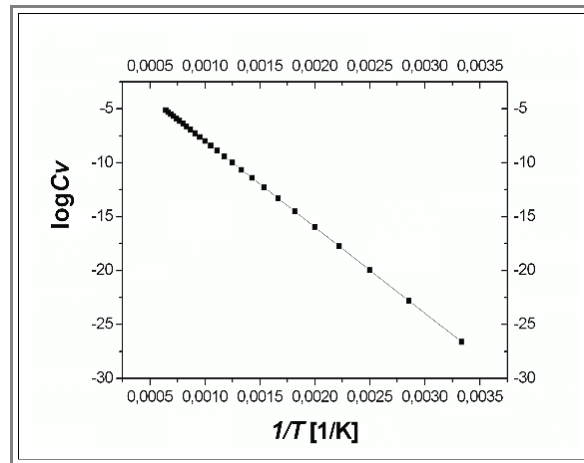
Übung 4.2-1

Gleichgewichtskonzentration von Leerstellen und Arrhenius Plot

Wir betrachten einen **Cu**-Kristall und einen **Si**-Kristall. Die Bildungsenergie einer Leerstelle sei **1 eV** und **4 eV** (grob richtig).

Fragen

1. Skizziere quantitativ die Konzentration $c_V = n/N_0$ der Leerstellen von ca. Raumtemperatur bis zum [Schmelzpunkt](#) (vom Link aus zu finden). Diskutiere kurz die Unterschiede von **Cu** und **Si**.
2. Ist eine direkte Darstellung von $c_V(T)$ wie oben gemacht sinnvoll? Warum ist eine Darstellung der Art $\lg c_V(1/T)$ viel sinnvoller? Stelle die Konzentration in diesem sogenannten **Arrhenius Plot** dar.
3. Bestimme aus dem nachfolgend gegebenen Arrhenius Plot die Bildungsenergie.



Lösung